4D16GS2666PNY22B | 16GB DDR4 2666 MEMORIA RAM (1X16GB) CL19 PNY

<>

MD16GSD42666-SI

MD16GSD42666-SI

5606628887693

- 16GB DDR4 (1x16GB)
- Velocidade de 2666MHz
- Latência CL19
- DIMM de 288 pinos para Desktop
- Alimentação de 1.2V

DESCRIÇÃO

Memória PNY Performance com 16GB de capacidade DDR4 (1x 16GB). Velocidade de 2666MHz, latência CL19 e alimentação de 1.2V.Formato DIMM de 288 pinos, para computadores de secretária.

CARACTERÍSTICAS

Tipo	DDR4
Interface	260 pinos
Velocidade	2666MHz
Tempo de acesso	0,75ns
CAS	CL19
Outras Características	• DDR4 SO-DIMM • Capacidade: 16GB (1×16GB) • Velocidade: 2666MHz • Latência: CL19 • Tensão: 1.2V • 260 pinos • Memória para notebooks • Non-ECC (a confirmar na ficha técnica)
Peso	15g

Peso com embalagem	20g
Origem	PRC
Dimensões	69.6 x 30 x 3.7 mm
Dimensões com Embalagem	n/a
Tipo de embalagem	Retail
Quantidade por Embalagem	1
Garantia	3 Anos

CE

RoHS COMPLIANT 2002/95/EC